

97-0213

Изобретение относится к фотоприемникам на основе полупроводников, в частности, к приемникам ультрафиолетового излучения, и может быть использовано в оптоэлектронных системах определения интенсивности и дозы ультрафиолетового излучения Солнца и других источников.

В структуре фотоприемника ультрафиолетового излучения с поверхностным потенциальным барьером, сформированной из полупроводников A^3B^5 с шириной запрещенной зоны E_{g1} , их твердых растворов с шириной запрещенной зоны E_{g2} и SnO_2 или ITO , в полупроводниках A^3B^5 на расстоянии от поверхности меньше длины поглощения видимого излучения сформирован изотипный гетеропереход между полупроводниками A^3B^5 и их твердыми растворами с шириной запрещенной зоны $E_{g2} > E_{g1}$.

Технический результат заключается в изготовлении фотоприемника чувствительного только к ультрафиолетовому излучению.

П. формулы: 1

Фиг.: 1